©RIKEN/JASRI

平成26年度　文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業　微細構造解析プラットフォーム

第１回放射光利用研究セミナー

日　時　平成26年9月5日（金）13：00～17：30

場　所　大阪大学大学院基礎工学研究科　国際棟セミナー室
（〒560-8531　大阪府豊中市待兼山町1-3）

主　催　独立行政法人　日本原子力研究開発機構　JAEA微細構造解析プラットフォーム
独立行政法人　物質・材料研究機構　NIMS微細構造解析プラットフォーム

共　催　大阪大学　大学院基礎工学研究科

プログラム

13:00 ～ 13:05	開会の挨拶	片山　芳則 日本原子力研究開発機構
13:05 ～ 13:20	ナノテクノロジープラットフォーム事業の紹介 微細構造解析プラットフォーム　ー放射光による研究支援ー	小西　啓之 日本原子力研究開発機構
13:20 ～ 13:50	利用研究セミナー1 X 線反射、CTR散乱及びレーザ吸収散乱法を用いた 窒化物半導体結晶成長の原子レベルその場観察	天野　浩 名古屋大学
13:50 ～ 14:20	利用研究セミナー2 放射光X線マイクロ回折を用いた窒化物半導体結晶評価	酒井　朗 大阪大学
14:20 ～ 14:50	利用研究セミナー3 光デバイス応用に向けたIn系窒化物半導体MBE成長	山口　智広 工学院大学
14:50 ～ 15:20	利用研究セミナー4 窒化物半導体を用いた深紫外LED開発	藤岡　陽 日亜化学工業（株）
15:20 ～ 15:40	休憩	
15:40 ～ 16:10	利用研究セミナー5 格子整合性に着目したSiC基板上窒化物半導体のMBE成長	須田　淳、金子　光顕 京都大学
16:10 ～ 16:40	利用研究セミナー6 窒化物半導体のパワーデバイス応用	石田　昌宏 パナソニック（株）
16:40 ～ 17:10	利用研究セミナー7 窒化物MBEにおける基礎検討事項：～GaAs系結晶成長との比較から～	石川　史太郎 愛媛大学
17:10 ～ 17:25	施設報告 その場放射光X線回折用窒化物半導体MBE装置の現状	高橋　正光 日本原子力研究開発機構
17:25 ～ 17:30	閉会の挨拶	高橋　正光 日本原子力研究開発機構

お申込・お問合せ　独立行政法人　日本原子力研究開発機構　関西光科学研究所
プロジェクト推進室　JAEA微細構造解析プラットフォーム事務局
E-Mail nanopla-office@ml.jaea.go.jp

電子メールにて受付
氏名、所属、部署、役職、住所（連絡先）、電話番号、FAX、E-mailをご記入のうえ上記までご送付ください。

参加無料
定員５０名
定員になり次第締め切りとさせていただきます